

2SB1309

エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ
低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.
Epitaxial Planar PNP Silicon Transistor

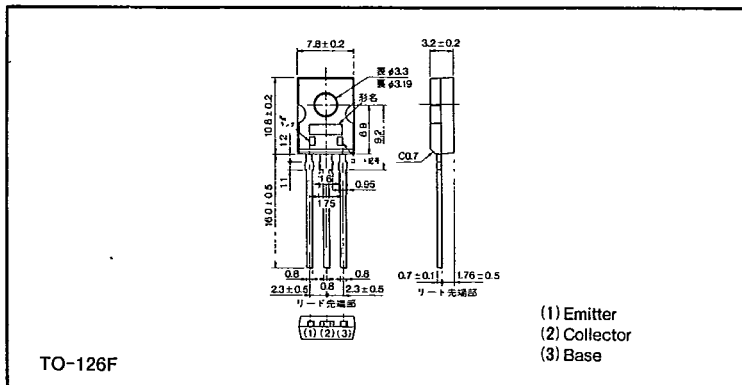
● 特長

- 裏面もモールドで覆われており、絶縁が不要である。
- 80Vの耐圧がある。
- 2SD1200とコンプリである。

● Features

- The rear surface of this device is also molded, eliminating the need for insulation.
- High breakdown voltage: -80V
- Complementary pair with 2SD1200.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I _C	-700	mA
コレクタ損失	P _C	5	W (T _C =25°C)
接合部温度	T _J	150	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-55~150	°C

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	-80	—	—	V	I _C = -2mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CBO}	-80	—	—	V	I _C = -50 μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	-5	—	—	V	I _E = -50 μA
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	—	—	-0.5	μA	V _{CB} = -50V
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	—	—	-0.5	μA	V _{EB} = -4V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	—	-0.2	-0.4	V	I _C /I _B = -500mA/-50mA
直流電流増幅率	h _{FE}	82	—	390	—	V _{CE} /I _C = -3V/-100mA
利得帯域幅積 (トランジション周波数)	f _T	—	100	—	MHz	V _{CE} = -10V, I _E = 50mA
出力容量	C _{ob}	—	14	20	pF	V _{CB} = -10V, I _E = 0, f = 1MHz

h_{FE}の値により下表のように分類します。

Item	P	Q	R
h _{FE}	82~180	120~270	180~390

● 標準品・準標準品一覧表

(◎:標準品 ○:準標準品)

Type	h _{FE}	包装名	バルク
2SB1309	PQR	基本発注単位(個)	1 000
			◎

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

T-33-17

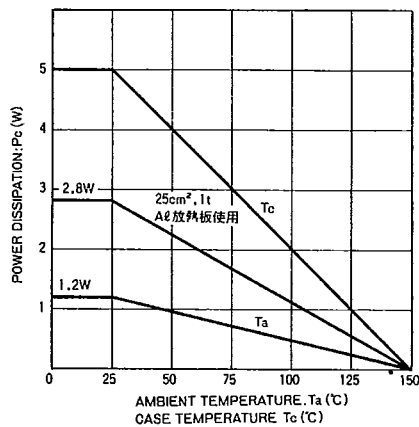


Fig.1 電力軽減曲線

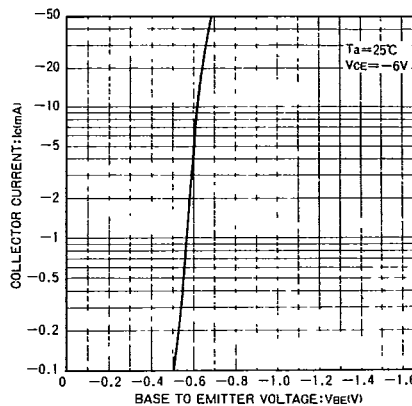


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

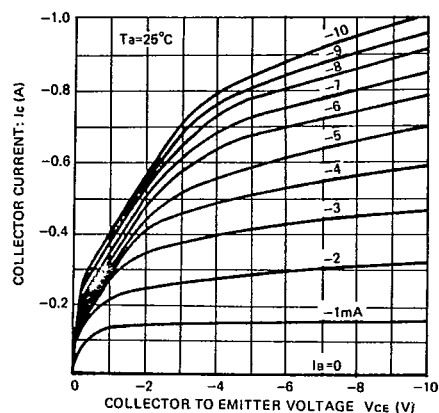


Fig.3 エミッタ接地出力静特性

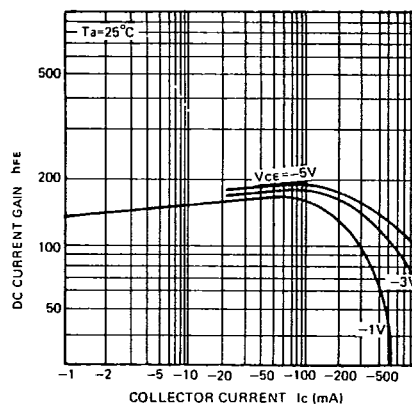


Fig.4 直流電流増幅率—コレクタ電流特性

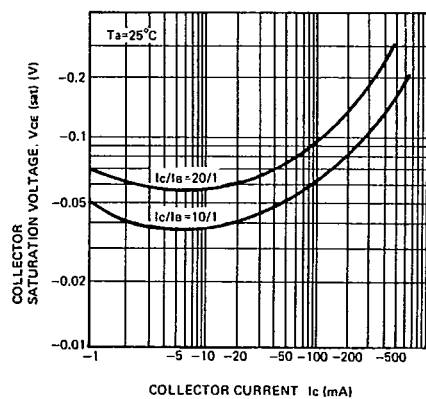


Fig.5 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性

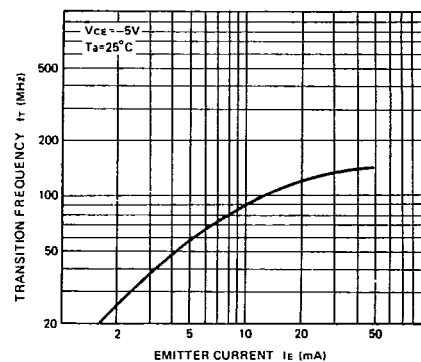


Fig.6 利得帯域幅積—エミッタ電流特性

トランジスタ



2SBタイプ

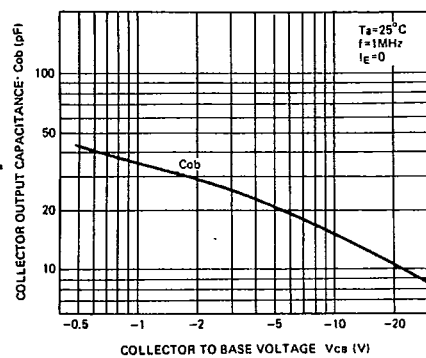


Fig.7 コレクタ出力容量—コレクタ・ベース電圧特性

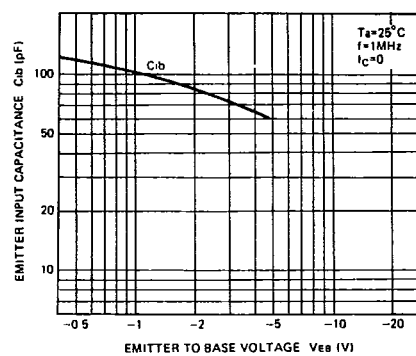


Fig.8 エミッタ入力容量—エミッタ・ベース電圧特性